

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 4 区分

【発行日】平成 24 年 4 月 12 日 (2012.4.12)

【公開番号】特開 2009-256784 (P2009-256784A)

【公開日】平成 21 年 11 月 5 日 (2009.11.5)

【年通号数】公開・登録公報 2009-044

【出願番号】特願 2009-60645 (P2009-60645)

【国際特許分類】

C 23C 14/04 (2006.01)

H 05B 33/10 (2006.01)

H 01L 51/50 (2006.01)

【FI】

C 23C 14/04 C

H 05B 33/10

H 05B 33/14 A

【手続補正書】

【提出日】平成 24 年 2 月 25 日 (2012.2.25)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

一方の面に、金属窒化物を含む第 1 の光吸収層と、前記第 1 の光吸収層に接して形成された材料層とを有し、他方の面に、金属窒化物を含む第 2 の光吸収層を有する第 1 の基板を用い、

前記第 1 の基板の前記材料層が形成された前記一方の面と、第 2 の基板の被成膜面とを対向させ、

前記第 1 の基板の前記第 2 の光吸収層を有する前記他方の面側から周波数 10 MHz 以上、パルス幅 100 fs 以上 10 ns 以下のレーザ光を照射し、前記第 1 の光吸収層と重なる位置にある前記材料層を加熱し、前記材料層の一部を前記第 2 の基板の被成膜面に成膜することを特徴とする成膜方法。

【請求項 2】

請求項 1 において、

前記金属窒化物は、窒化チタン、窒化タンタル、窒化モリブデン、窒化タングステン、窒化クロムのいずれかであることを特徴とする成膜方法。

【請求項 3】

請求項 1 または請求項 2 において、

前記第 1 の光吸収層及び前記第 2 の光吸収層における窒素原子の含有量は、金属原子を 1 とすると、0.1 以上 1.3 以下の割合であることを特徴とする成膜方法。

【請求項 4】

請求項 1 乃至請求項 3 のいずれかにおいて、

前記第 1 の光吸収層が島状に形成されていることを特徴とする成膜方法。

【請求項 5】

請求項 1 乃至請求項 4 のいずれかにおいて、

前記第 1 の光吸収層がストライプ状に形成されていることを特徴とする成膜方法。

【請求項 6】

請求項 1 乃至請求項 5 のいずれかーに記載の成膜方法を用い、
前記材料層の一部を、前記第 2 の基板の被成膜面上に形成されている第 1 の電極上に成膜
することを特徴とする発光装置の作製方法。